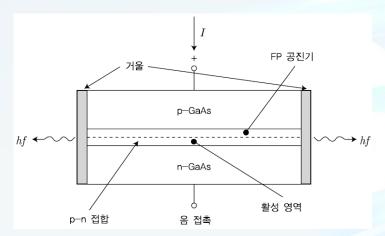


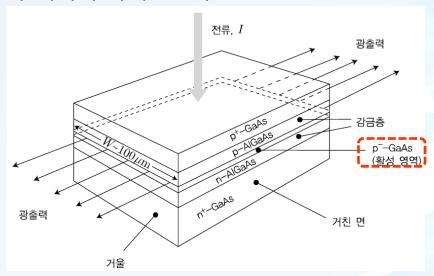




- 레이저다이오드의 변천과 종류
  - FP 공진기형 GaAs LD
    - 1세대 광통신에서 사용
    - 동종접합 구조이므로, 활성 영역이 넓게
      분포하여 문턱 전류 Ith가 지나치게 높고
      빛을 집속시켜 광섬유와 결합하기가 어려워 더 이상 사용하지 않음



- 레이저다이오드의 변천과 종류
  - 이중 이종접합(DH) 구조의 LD
    - LED와 비슷하게 이중 이종접합 구조
    - 양쪽 측면은 거칠게 처리되어 빛이 밖으로 투과되지 않음
    - LD의 전체 폭에 걸친 넓은 영역으로 전류가 흐르므로, 광 폭 레이저 다이오드라고 불림



#### • DH 구조의 반도체 다이오드

[광통신용 광원 제작에 사용하는 화합물 반도체와 출력 파장]

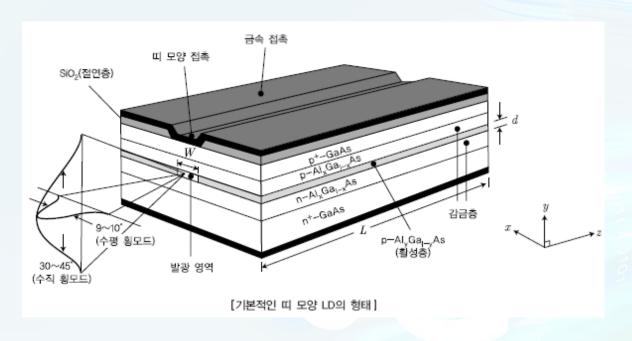
활성 영역/감금 영역	파장 범위[μm]	기판
GaAs/Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As	0.8~0.9	GaAs
GaAs/In <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> P	0.9	GaAs
Al <sub>y</sub> Ga <sub>1-y</sub> As/Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As	0.65~0.9	GaAs
In <sub>y</sub> Ga <sub>1-y</sub> As/In <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> P	0.85~1.1	GaAs
GaAs <sub>1-x</sub> Sb <sub>x</sub> /Ga <sub>1-y</sub> Al <sub>y</sub> As <sub>1-x</sub> Sb <sub>x</sub>	0.9~1.1	GaAs
Ga <sub>1-y</sub> Al <sub>y</sub> As <sub>1-x</sub> Sb <sub>x</sub> /GaSb	1.0~1.7	GaSb
In <sub>1-x</sub> Ga <sub>x</sub> As <sub>y</sub> P <sub>1-y</sub> /InP	0.92~1.7	InP
In <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As/InGaAIAs	1,3	InGaAs
In <sub>1-x</sub> GaN <sub>y</sub> As <sub>1-y</sub> /GaNAs	1,3~1,55	GaAs
In <sub>1-x</sub> Ga <sub>x</sub> N <sub>1-y</sub> As <sub>y</sub> Sb/Ga <sub>1-x</sub> Al <sub>x</sub> As	1,31	GaAs

약 1~1.7µm 범위의 파장을 갖는 광파를 발생시킬 수 있으므로, 광섬유의 손실이 최저가 되는 1.55µm 파장 대역을 사용하는 현대의 장거리 광통신 시스템에서 널리 사용

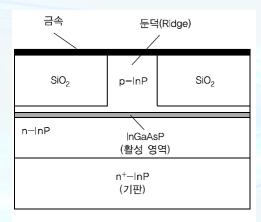


- 띠 모양 LD
  - 광폭 LD의 단점
    - 전류가 흐르는 면적이 넓어 문턱 전류가 높은 편
    - LD 폭 전체에 걸쳐 빛이 방출되므로, 광섬유의 코어로 집속시키기 어려움
  - 활성 영역의 폭이 W로 제한된 띠 모양 LD 개발 → 띠 모양 LD
    - 활성 영역 중 폭 W 이외에는 저항값을 높이거나  $SiO_2$  와 같은 절연체를 증착해 전류 흐름이 폭 이내로 제한되게 제조
    - 전류 흐름은 활성 영역의 이득을 결정
    - 광 출력 역시 띠 모양 안으로 제한
    - 이득 도파형(gain-guiding) 이라고도 함

■ 띠모양LD

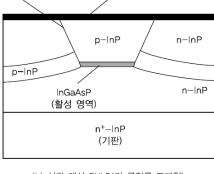


- 굴절률 도파형(index-guiding) LD
  - 레이저 출력이 증가하면 방사형태가 달라지는 이득 도파 형 LD의 단점 보완
  - 띠 모양 안으로 전류를 제한할 뿐만 아니라, 횡축 방향으로 활성 영역의 굴절률을 변화하여 활성 영역이 막대 모양의 도파관 역할을 함
  - 굴절률의 변화에 따라 약 굴절률 도파형과 강 굴절률 도 파형으로 세분
  - 둔덕 도파로(ridge waveguide, RWG) LD
    - 구조가 간단하고 제조 비용이 낮아 일부 응용분야에서 사용



(a) RWG LD(약 굴절률 도파형)

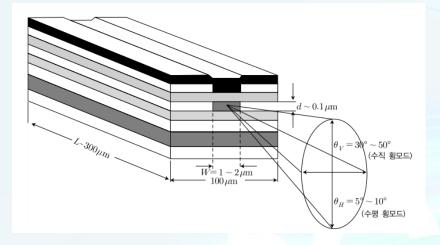
- 매몰 이종접합(BH, Buried Heterostructure) 구조 LD
  - 강 굴절률 도파형 LD의 일종
  - 활성 영역이 굴절률이 낮은 주위 영역에 둘러싸여 매몰되어 있는 구조
  - 횡축 방향으로 굴절률 차이가 상대적으로 커서 (Δn~0.1), 출력되는 빛이 잘 퍼지지 않음
  - 문턱 전류가 10~20mA 정도로 낮아, 광통신에서 널리 사용되고 있다.



(b) 식각 메사 BHLD(강 굴절률 도파형)

- 매몰 이종접합(BH, Buried Heterostructure)
  구조 LD
  - 대부분의 광통신에서 사용하는 LD 구조
  - 활성 영역의 폭(W)과 두께(d)에 의해서도 출력되는 빛의 특성이 영향 받음
    - W와 d는 LD의 횡모드(transverse mode) 결정
    - 횡모드는 출력광의 공간분포, 즉 방사형태를 결정
    - 횡모드 = 공간모드(spatial mode)
  - 활성 영역의 길이(L)은 종모드(longitudinal mode)를 결정
  - 매몰 이종접합 LD의 횡모드

■ 매몰 이종접합(BH, Buried Heterostructure) 구조 LD



- 두께(d) 는 문턱전압 낮추기 위해 작게(~ 0.1μm) 제작
- → 따라서 수직 횡모드는 기본모드만 출력
- 폭(W) 은 보통 2 μm 이하
- → 수평 횡모드 역시 기본모드만 출력



#### ▶반도체 LD의 종류

